

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

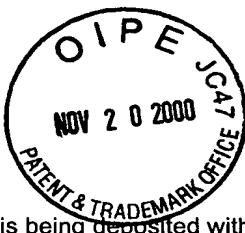
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

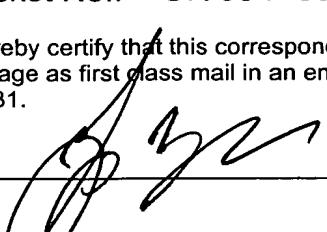
**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

4



Docket No.: GR 98 P 3052 P

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

By: 

Date: November 15, 2000

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Roland Rupp et al.
Appl. No. : 09/630,154
Filed : July 31, 2000
Title : Device for Mounting a Substrate and Method for Producing an Insert for a Susceptor

CLAIM FOR PRIORITY

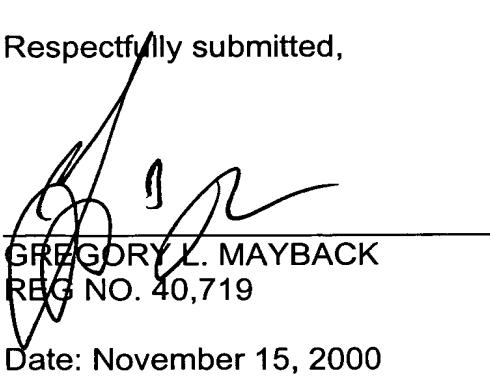
Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 198 03 423.7 filed January 29, 1998.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,



GREGORY L. MAYBACK
REG NO. 40,719

Date: November 15, 2000

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

/mjb

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 198 03 423.7

Anmeldetag: 29. Januar 1998

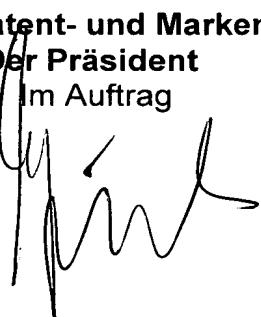
Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung: Substrathalterung für SiC-Epitaxie

IPC: H 01 L, C 30 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 13. Juli 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
im Auftrag



Agurks

Beschreibung

Substrathalterung für SiC-Epitaxie

5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor als Unterlage für das zu beschichtende Substrat umfaßt, sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Suszeptors.

10 Das Aufwachsen von einer einkristallinen Schicht erfolgt bei Siliciumcarbid bei sehr viel höheren Temperaturen als bei anderen Halbleitern wie Silicium oder Galliumarsenid. Daher besteht ein Hauptproblem bei der Siliciumcarbid-Epitaxie in der Wahl eines geeigneten Materials als Unterlage und Be-
festigung des SiC-Wafers. Grund hierfür ist zum einen die hohe Prozeßtemperatur zwischen 1300°C und 2000°C und zum anderen die Notwendigkeit, einen Wasserstoffpartialdruck in der Prozeßkammer von etwa 10 kPa (0,1 atm) aufrecht zu erhalten, um ein einkristallines Wachstum mit akzeptablen
15 Wachstumsraten ($> 1 \mu\text{m}/\text{h}$) zu ermöglichen. Außerdem muß eine Reaktion des Materials, das in direkten Kontakt zum SiC-Substrat steht, mit diesem Substrat verhindert werden.

20 Aufgrund dieser Anforderungen werden beim Stand der Technik als Materialien beschichteter und unbeschichteter Graphit sowie Werkstoffe aus Übergangsmetallen verwendet.

25 Aufgrund dieser Anforderungen werden beim Stand der Technik als Materialien beschichteter und unbeschichteter Graphit sowie Werkstoffe aus Übergangsmetallen verwendet.

Unbeschichteter Graphit ist formstabil und chemisch völlig inert gegenüber SiC. Selbst bei sehr hohen Temperaturgra-
dienten kommt es zu keiner Rißbildung durch thermische Spannungen.

Bei der genannten hohen Prozeßtemperatur von 1300 bis 1600°C und einem Wasserstoffpartialdruck von etwa 10 kPa kommt es 30 jedoch zu einer Reaktion mit dem Wasserstoff unter Bildung von Kohlenwasserstoffen. Auch wenn die Abtragsraten in der Größenordnung von $1 \mu\text{m}/\text{h}$ sind, verschieben diese Kohlen-

wasserstoffe das durch die verwendeten Prozeßgase wie z.B. Silan, Propan vorgegebene Verhältnis von Kohlenstoff zu Silicium im Bereich der Substratoberfläche hin zu Überschuß an Kohlenstoff. Dieser Effekt ist ortsabhängig und erzeugt

5 Inhomogenitäten im Substrat. Weiterhin werden im Graphit enthaltene Verunreinigungen freigesetzt (Al, Ti, B) und in die Epitaxieschicht eingebaut. Eine Verschlechterung der Eigenschaften dieser Schicht sind die Folge.

10 Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden in den letzten Jahren verstärkt Graphitteile für die Halterung des Wafers verwendet, die mit Siliciumcarbid (SiC) beschichtet sind. Eine Reaktion des Wasserstoffs mit dem Graphit kann dadurch verhindert werden, daß diese Beschichtung gasdicht gemacht wird.

15 Andererseits führt die Beschichtung zu einer deutlichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften der Teile. Temperaturgradienten in den mechanischen Teilen können zu Rissen in der Beschichtung und sogar zu einem Brechen des 20 gesamten Teils führen. Auch nicht durchgängige Risse führen bei der üblicherweise verwendeten induktiven Heizung zu einer unkontrollierbaren Beeinflussung der Temperaturverteilung.

25 Darüber hinaus besteht das Problem, daß es durch den Kontakt des Wafers mit einer mit SiC beschichteten Oberfläche zu einem unerwünschten Aufwachsen von SiC kommt. Dieses Problem wird durch die hohen Prozeßtemperaturen verstärkt. Der Transportvorgang erfolgt insbesondere von der Unterlage zur Rückseite des Wafers.

30 Ebenso ist aus der Literatur die Verwendung von Übergangsmetallen wie Mo und Ta als Suszeptor für die SiC-Epitaxie bekannt. Beide Übergangsmetalle besitzen einen niedrigen Dampfdruck und werden vom Wasserstoff nicht angegriffen. Wie 35 Graphit ertragen diese Metalle hohe thermische Spannungen.

Die Diffusionskonstanten von Verunreinigungen in diesen Metallen sind jedoch hoch, so daß z.B. in den Übergangsmetallen enthaltenes Al durch diesen Vorgang in die Prozeßatmosphäre gelangen und die Eigenschaften der Epitaxieschicht

5 verschlechtern kann. Beide Metalle bilden außerdem Silicide und Carbide, es kommt somit zu einer Reaktion mit der Waferrückseite bzw. mit den Spaltprodukten des Silan und Propan. Damit ändern sich zeitabhängig die optische Eigenschaften der Materialoberfläche. Da der Wärmetransport bei den hohen Pro-
10 zeßtemperaturen zu einem wesentlichen Teil über Strahlung erfolgt, ergeben sich daraus wiederum unerwünschte Rückwirkungen auf die Temperaturverteilung der Waferauflage. Ta-
besitzt weiterhin die Neigung, bei hohen Temperaturen Wasser-
stoff in seinem Kristallgitter einzulagern, was bei einem
15 raschen Abkühlprozeß zu einer Zerstörung des Werkstücks führt. Üblicherweise muß daher der Abkühlprozeß bei etwa 1000° für ca. 1 h angehalten werden und die H-Atmosphäre z.B. durch Ar ausgetauscht werden. Dies führt zu einer unerwünsch-
ten Verlängerung des Gesamtprozesses und höheren Kosten.

20 5 Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Substrat-
halterung zu schaffen, die eine Kontaminierung des Substrats bei der Bearbeitung, z.B. bei einer Erzeugung einer Epita-
xieschicht auf dem Wafer, ausschließt, sowie ein Herstel-
lungsverfahren dafür anzugeben.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung zum Haltern eines Substrats mit den Merkmalen nach Anspruch 1 und ein Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors nach Anspruch 11.
30 Die Unteransprüche beziehen sich auf bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung.

Die Erfindung beruht darauf, zumindest Teile der Hilfsmate-
rialien, die sich beim SiC-Epitaxieprozeß im Bereich hoher
35 Temperatur befinden, durch Metallcarbide zu ersetzen. Dazu wird vorgeschlagen, die Oberfläche der Teile, die mit dem SiC-Substrat unter den genannten Umgebungsbedingungen in

Berührung kommen, zu versiegeln, d.h. gasdicht zu beschichtet, so daß von den Teilen kein kontaminierendes Material über die Oberfläche in das Substrat eingebaut werden (diffundieren) kann. Hierbei sind solche hochtemperaturstabilen

5 Carbide zu wählen, die sowohl gegenüber Wasserstoff inert sind als sich auch gegenüber SiC im chemischen Gleichgewicht befinden. Weiterhin darf der Carbid-Bildner keine elektrisch aktive Verunreinigung im SiC sein (Al- und Borcarbid scheiden daher aus). Besonders geeignet sind: TaC, MoC, NbC, WC.

10

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor als Unterlage für das zu beschichtende Substrat umfaßt, ist dadurch gekennzeichnet, daß der Suszeptor einen Einsatz umfaßt, dessen Oberfläche wenigstens 15 teilweise mit einer Metallcarbid-Schicht vorgegebener Dicke bedeckt ist.

Vorzugsweise ist der Einsatz so aufgebaut, daß er in seinem Querschnitt eine „sandwich“-Struktur aufweist, d.h. er 20 besteht aus einem Kern, vorzugsweise aus Graphit oder einem Metall, der mit der Metallcarbid-Schicht bedeckt ist.

Die Dicke der Metallcarbid-Schicht auf dem Einsatz kann mit dem Abstand vom Wafer sinken. Damit ist vor allem die Oberfläche in der direkten Umgebung des Wafers versiegelt, so 25 daß es zu keiner Diffusion kontaminierenden Materials zu dem Wafer von Teilen kommt, die direkt mit diesem in Berührung kommen. Dadurch werden auch die Herstellungskosten der entsprechenden, mit dem Wafer in Berührung kommenden Teile 30 gesenkt.

Vorzugsweise besteht die Metallcarbid-Schicht aus TaC, MoC, NbC oder WC.

35 Der Einsatz kann mehrere Kacheln für jeweils ein Substrat umfassen, wobei jede Kachel darüber hinaus eine Vertiefung für ein Substrat aufweisen kann.

Das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren für Einsätze mit einer Oberflächenschicht aus Metallcarbiden beruht auf dem Temperiern einer in SiC-Pulver eingebetteten Vorform zwischen 5 1500°C und 2000°C und der anschließenden Hartbearbeitung zur endgültigen Formgebung. Mit diesem Prozeß wird ein Verbundwerkstoff erzeugt, der aus einer je nach Temperbedingungen mehr oder weniger dicken Carbid-Oberflächenschicht und noch nicht carbidisiertem Metall im Inneren besteht. Die Korn-10 grenzen in diesem Metall sind dabei ebenfalls zumindest teilweise carbidisiert.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors mit einer Oberflächenschicht aus Metallcarbid umfaßt 15 die Schritte Erzeugen einer metallischen Vorform, Einbetten der metallischen Vorform in ein kohlenstoffhaltiges Pulver, Aufheizen der metallischen Vorform und des kohlenstoffhaltiges Pulvers auf eine erhöhte Temperatur, Hartbearbeiten der getemperten Vorform und Anordnen der hartbearbeiteten 20 Vorform an dem Suszeptor als Einsatz.

Vorzugsweise liegt bei dem Verfahren die erhöhte Temperatur zwischen 1500°C und 2000°C und erfolgt das Aufheizen unter erhöhtem Druck.

Das kohlenstoffhaltige Pulver umfaßt insbesondere Siliciumcarbid-Pulver.

Die Erfindung hat die folgenden Vorteile. Es kommt zu keiner 30 Reaktion der Waferumgebung mit dem SiC sowie mit dem Prozeßgas der Epitaxie wie z.B. Propan, Silan und Wasserstoff. Damit wird die Reinheit der Epitaxieschicht verbessert und eine höhere Lebensdauer des Werkstücks erreicht. Die mechanischen Eigenschaften der Substrathalterkomponenten sind 35 gut, da Carbide an sich spröde sind, durch den duktilen metallischen Kern die Gesamtform jedoch stabilisiert wird und damit eine größere Flexibilität beim Design von Sus-

zeptor, Probenhalter usw. möglich ist. Außerdem wird die Diffusion in den Carbiden gegenüber den Metallen stark reduziert. Als „Diffusionsbremsen“ wirken insbesondere die Korngrenzen im metallischen Gefüge. Damit wird eine ver-

5 besserte Reinheit der Epitaxieschicht erreicht. Schließlich wird die Einlagerung von Wasserstoff in das Kristallgitter unterbunden, wodurch eine rationelle Prozeßführung ermöglicht wird.

10 Die Erfindung wird im folgenden zum besseren Verständnis anhand zeichnerisch dargestellter Ausführungsbeispiele erläutert, wobei Bezug genommen wird auf die beigefügten Zeichnungen.

15 Figur 1 zeigt eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Graphit-Suszeptors mit Carbid-Einsatz im Querschnitt. Figur 2 zeigt im Querschnitt das Gefüge eines mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Einsatzes für den Graphit-Suszeptor nach Figur 1.

20 Figur 3 zeigt eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Einsatzes für eine Multiwafer-Epitaxieanlage im Aufriß.

25 Figur 1 stellt im Querschnitt eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Suszeptors 1 dar. Vorzugsweise wird der Suszeptor 1 aus Graphit hergestellt, damit er optimale Wärmeleitfähigkeit besitzt und für eine Induktionsheizung (mit Wirbelstrom) die entsprechenden optimalen elektrischen Eigenschaften aufweist. Die genaue Form des Suszeptors 1 kann ohne Einschränkung durch die Erfindung an den Ofen angepaßt werden. So kann der Suszeptor 1 Verlängerungen 4 aufweisen, die als Gestell zur Befestigung in einem (nicht dargestellten) Ofen dienen. Die Verlängerungen 4 an der Seite des Suszeptors 1 in Figur 1 können aus demselben Material wie der Suszeptor 1 bestehen und mit diesem einstückig verbunden sein oder aus einem anderen Material geformt sein und mit dem Suszeptor 1 formschlüssig verbunden sein.

Auf einer Oberseite weist der Suszeptor 1 erfindungsgemäß eine Vertiefung für einen Einsatz 2 auf. Diese Vertiefung dient zur Aufnahme einer oder mehrerer Kacheln oder Einsätze 5 2, auf denen jeweils ein Wafer oder ein Substrat 3 aus einem Halbleitermaterial liegt. Insbesondere, aber nicht ausschließlich ist, wie oben bereits erläutert, die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Halterung eines Substrats für Halbleitermaterialien geeignet, die bei sehr hohen Temperaturen 10 bearbeitet werden müssen, wie SiC etc.. Die Verarbeitung des Substrats aus SiC kann z.B. das epitaxiale Aufwachsen von SiC auf dem Substrat beinhalten.

Der erfindungsgemäße Einsatz 2 in dem Suszeptor 1 muß einerseits einer sehr hohen Temperaturbelastung standhalten und darf andererseits nicht durch die H-Atmosphäre in seinen Eigenschaften beeinträchtigt werden. Erfindungsgemäß besteht der Einsatz 2 daher aus einem temperaturstabilen Carbid, das gegenüber Wasserstoff inert ist und sich mit SiC im chemischen Gleichgewicht befindet. 20

Damit durch das Kation im Carbid keine Verunreinigung in das Siliciumcarbid eingebracht wird, scheiden einige Metalle als Carbid-Kationen aus, insbesondere Al und B, die sonst in das SiC diffundieren oder in die Epitaxieschicht eingebaut werden und als Akzeptoren wirken könnten. Vorzugsweise werden daher als Kationen des Carbids Tantal, Molybdän, Niob, Wolfram und weitere Nebengruppenelemente wie Cr, Hf, V etc. eingesetzt. 25

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der Einsatz 2 durch Sintern oder Temperiern eines Gemisches aus Metallpulver und Kohlenstoff hergestellt. Unter Druck und bei hoher Temperatur kommt es in dem Pulvergemisch zu einer Carburierung. Ein Querschnitt durch den so gewonnenen Verbundwerkstoff ist als Teil des Einsatzes 2 in Figur 2 gezeigt. Die Oberfläche 5 des Einsatzes 2 wird im wesentlichen durch Carbid 6 gebildet, während tiefer in dem Einsatz 2 das

Metall in Form metallischer Gefügekörner 7 vorliegt. Die metallischen Körner 7 weisen jeweils eine Korngrenze 8 auf, an der das Metall ebenfalls wenigstens teilweise carbidiert ist.

5

Bei einer anderen bevorzugten (nicht dargestellten) Ausführungsform der Erfindung wird eine „Sandwich“-Struktur als Einsatz verwendet, bei der die Oberfläche eine Schicht aus Metallcarbid ist, die mit einer anderen Technik als der in dem obigen Absatz beschriebenen aufgebracht wird (z.B. Abscheidung aus der Gasphase etc.), und bei der der Kern des Einsatzes 2 ein Graphit-Körper oder ein Metallkörper ist.

10 Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß die Formgebung des Einsatzes 2 einfacher ist als bei der obigen Herstellung 15 mittels Sintern oder Temfern des gesamten Einsatzes.

Insbesondere kann bei der letztgenannten Struktur die Dicke der Schicht aus Metallcarbid besonders einfach eingestellt werden, so daß vor allem die Teile in unmittelbarer Nähe des 20 Wafers versiegelt sind. Als Kern des Einsatzes 2 kommen wiederum verschiedene Materialien in Frage, wie z.B. Graphit, Metalle wie Mo, W, Hf usw. und weitere Verbundmaterialien, die den Anforderungen an Temperatur und chemischer Belastung standhalten.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors mit einer Oberflächenschicht aus Metallcarbid beruht auf dem Temfern bzw. Sintern einer in SiC-Pulver eingebetteten Vorform, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 30 1500°C und 2000°C, und der anschließenden Hartbearbeitung zur endgültigen Formgebung. Mit diesem Prozeß wird ein Verbundwerkstoff erzeugt, der aus einer je nach Temperbedingungen mehr oder weniger dicken Carbid-Oberflächenschicht und noch nicht carbidiertem Metall im Inneren 35 besteht.

Figur 3 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Einsatzes in seiner Gesamtgröße. Im Außenbereich ist der Suszeptor 1 dargestellt. Der Einsatz 2 setzt sich aus mehreren Kacheln 9 zusammen, die alle im wesentlichen eine solche Form haben, daß ein (nicht dargestellter) Wafer 3 auf ihnen Platz findet. In der dargestellten Ausführungsform des Einsatzes 2 ist dieser für 6 Wafer ausgelegt. Der Suszeptor 1 wird um eine Achse, die durch die Mitte des Suszeptors 1 in Figur 3 senkrecht zur Zeichenebene verläuft, gedreht. Die Rotation kann je nach Bearbeitungsschritt der Wafer 3 mit höherer Geschwindigkeit erfolgen, u. a. um einen stabilen Gasstrom in der (nicht dargestellten) Kammer oder dem Ofen bei der Bearbeitung zu gewährleisten. Damit die Wafer 3 bei der Drehung einen definierten Abstand zueinander einhalten und nicht verrutschen, ist in jeder Kachel 9 eine Vertiefung 10 vorgesehen, deren Durchmesser dem Durchmesser eines Wafers entspricht. Damit ist der in Figur 3 dargestellte Einsatz 2 für Multiwafer-Epitaxieanlage besonders geeignet.

Ein weiterer Vorteil der Ausführungsform nach Figur 3 liegt darin, daß definierte Umgebungsbedingungen für die Wafer geschaffen werden können. Eine Kombination der Carbide mit Graphit oder auch Metallen wie Ta, Mo, W beim Gesamtaufbau ist nämlich insbesondere in der heißen Zone eines Epireaktors wünschenswert und im chemischen Gleichgewicht möglich. Da für den Verunreinigungseintrag insbesondere die direkte Umgebung des Wafers kritisch ist, werden vorzugsweise dort die Carbide eingesetzt. Durch die Vertiefung 10 in den Kacheln 9 kann so verhindert werden, daß der Wafer 3 verrutscht und an einen Ort gelangt, bei dem weniger Carbide vorliegen, so daß es zu einer Kontamination des Wafers kommen kann.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor (1) als Unterlage für das zu beschichtende Substrat (2) umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß der Suszeptor (1) einen Einsatz (3) umfaßt, dessen Oberfläche (5) wenigstens teilweise mit einer Metallcarbid-Schicht (6) vorgegebener Dicke bedeckt ist.
- 10 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz (3) mehrere Kacheln (9) für jeweils ein Substrat (3) umfaßt.
- 15 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jede Kachel (9) eine Vertiefung (10) für ein Substrat (3) aufweist.
- 20 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz (3) einen Graphit-Kern umfaßt, der mit der Metallcarbid-Schicht (6) bedeckt ist.
- 25 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz (3) einen Metall-Kern (7) umfaßt, der mit der Metallcarbid-Schicht (6) bedeckt ist.
- 30 6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Metallcarbid-Schicht (6) mit dem Abstand vom Wafer (3) sinkt.
- 35 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallcarbid-Schicht (6) für den Einsatz (3) Tantalcarbid umfaßt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, durch gekennzeichnet, daß die Metallcarbid-Schicht (6) für den Einsatz (3) Niobcarbid umfaßt.
- 5 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, durch gekennzeichnet, daß die Metallcarbid-Schicht (6) für den Einsatz (3) Wolframcarbid umfaßt.
- 10 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, durch gekennzeichnet, daß die Metallcarbid-Schicht (6) für den Einsatz (3) Molybdaencarbid umfaßt.
- 15 11. Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit einer Oberflächenschicht (6) aus Metallcarbid, gekennzeichnet durch die Schritte:
Erzeugen einer metallischen Vorform,
Einbetten der metallischen Vorform in ein kohlenstoffhaltiges Pulver,
20 Aufheizen der metallischen Vorform und des kohlenstoffhaltigen Pulvers auf eine erhöhte Temperatur,
Hartbearbeiten der getemperten Vorform,
Anordnen der hartbearbeiteten Vorform an dem Suszeptor (1)
als Einsatz (2).
25
12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufheizen unter erhöhtem Druck erfolgt.
- 30 13. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die erhöhte Temperatur zwischen 1500°C und 2000°C liegt.
- 35 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das kohlenstoffhaltige Pulver Siliciumcarbid-Pulver umfaßt.

Zusammenfassung

Substrathalterung für SiC-Epitaxie

5 Es wird eine Substrathalterung, die eine Kontaminierung des Substrats bei der Bearbeitung, z. B. bei einer Erzeugung einer Epitaxieschicht auf dem Wafer, ausschließt, sowie ein Herstellungsverfahren dafür angegeben.

10 Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine solche Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor (1) als Unterlage für das zu beschichtende Substrat (2) umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß der Suszeptor (1) einen Einsatz (3) umfaßt, dessen Oberfläche (5) wenigstens teilweise mit 15 einer Metallcarbid-Schicht (6) vorgegebener Dicke bedeckt ist.

Zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit einer Oberflächen-
schicht (6) aus Metallcarbid, werden die Schritte Erzeugen
20 einer metallischen Vorform, Einbetten der metallischen
Vorform in ein kohlenstoffhaltiges Pulver, Aufheizen der
metallischen Vorform und des kohlenstoffhaltiges Pulvers auf
eine erhöhte Temperatur, Hartbearbeiten der getemperten Vor-
form, Anordnen der hartbearbeiteten Vorform an dem Suszeptor
25 (1) als Einsatz (2) durchgeführt.

FIG 2

1/2

FIG 1

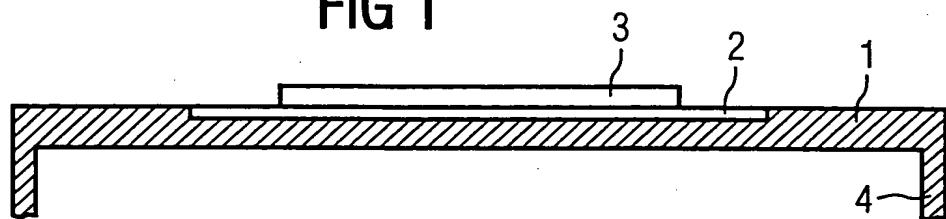
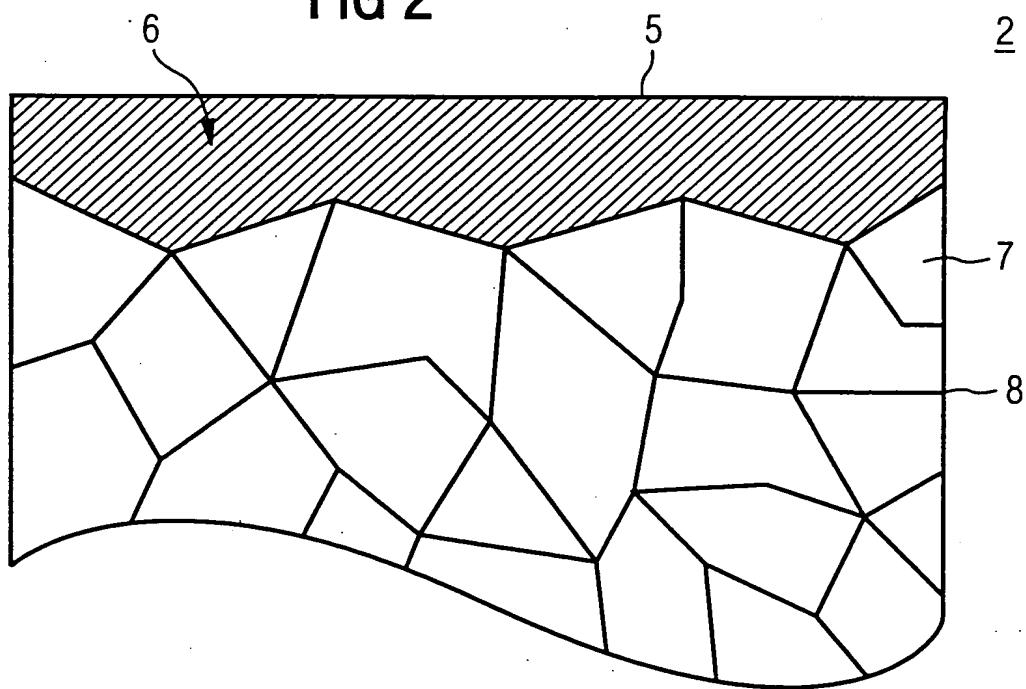


FIG 2



2/2

FIG 3

